性能特点：

- 通带频段：0.1～2.0GHz
- 通带损耗：0.5 dB
- 均衡量：5.0dB
- 回波损耗：20dB
- 芯片尺寸：0.85mmx1.30mm x 0.10mm

产品简介：

HH-AE0P12-5是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点，广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现，性能不受外部盒体影响，使用简单方便。

电参数：（T_A=25℃）

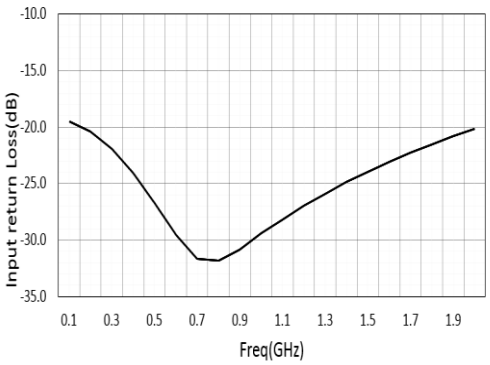
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	0.1~2.0			GHz
插入损耗	0.5	-	5.5	dB
均衡量	-	5.0	-	dB
输入回波损耗	20	-	-	dB
输出回波损耗	20	-	-	dB

使用限制参数：(超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

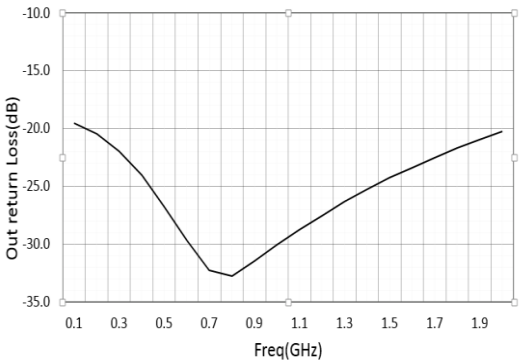
最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65℃～+150℃
使用温度	-55℃～+85℃

典型曲线：（T_A=+25℃）

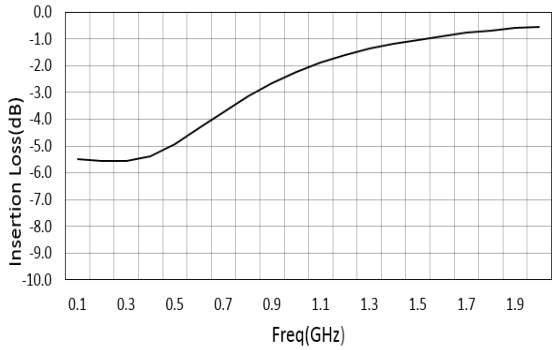
输入回波损耗



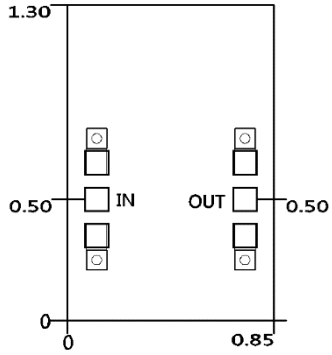
输出回波损耗



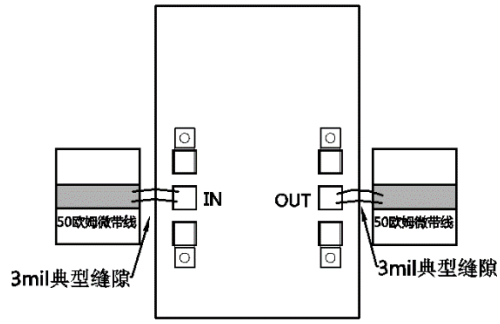
插入损耗



尺寸图：（单位 mm）



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。